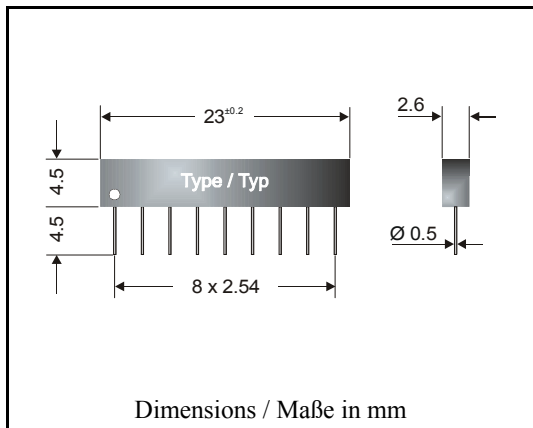
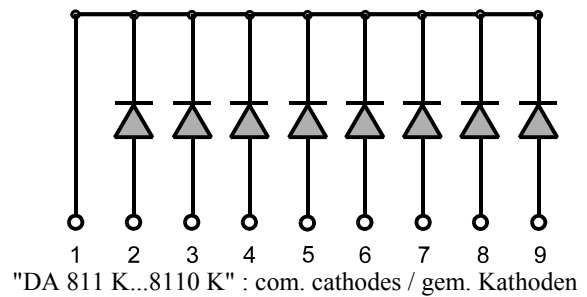
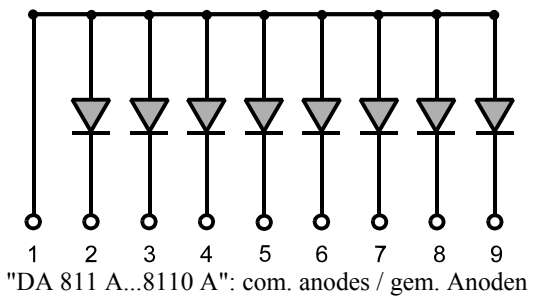


Rectifier Arrays

Gleichrichter Sätze



Nominal power dissipation	1.2 W
Nenn-Verlustleistung	
Repetitive peak reverse voltage	100...1000 V
Periodische Spitzensperrspannung	
9 Pin-Plastic case	23 x 2.6 x 4.5 [mm]
9 Pin-Kunststoffgehäuse	
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk	see page 22
Standard Lieferform: lose im Karton	s. Seite 22



Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DA 811 A/K	100	120
DA 814 A/K	400	480
DA 8110 A/K	1000	1200

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 600 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb	$T_U = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} 600 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM} 30 A

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	$1.2\text{ W}^1)$
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	$-50\dots+150^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R I_R	$< 10\ \mu\text{A}$ $< 90\ \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 85\text{ K/W}^1)$

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten